

## Сведения о ведущей организации

Полное и сокращенное наименование ведущей организации	Акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Полюс» имени М.Ф. Стельмаха» (АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха»)
Структурное подразделение	Научно-производственный комплекс "Квантовая электроника и радиофотоника"
Место нахождения	РФ, г. Москва
Адрес	117342, г. Москва, ул., Введенского, д. 3, корп. 1
Телефон	+7 495 333-00-03
Адрес электронной почты	bereg@niipolyus.ru
Адрес сайта в сети «Интернет» (при наличии)	<a href="https://niipolyus.ru/">https://niipolyus.ru/</a>
Список основных публикаций работников организации по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Слипченко С. О. и др. Источник мощного импульсного лазерного излучения (1060 нм) с высокой частотой следования импульсов на основе гибридной сборки линейки лазерных диодов и 2D массива оптодиодов как высокоскоростного токового ключа //Квантовая электроника. – 2023. – Т. 53. – № 1. - С. 11-16.</li> <li>2. Babichev A. V. et al. Heterostructures of quantum-cascade lasers based on composite active regions //Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics. – 2023. – Т. 87. – №. 6. – С. 839-844.</li> <li>3. Veselov D. A. et al. Implementation of energy barrier layers for 1550 nm high-power laser diodes //Journal of Luminescence. - 2023. - Т. 263. – С. 120164.</li> <li>4. Сравнение способов монтажа мощных решеток лазерных диодов в корпусе на медный теплоотвод / Д. С. Иванов, Н. В. Гулькиков, А. И. Данилов [и др.] // ФОТОНИКА 2023: Тезисы докладов Российской конференции и школы молодых ученых по актуальным проблемам полупроводниковой фотоэлектроники (с участием иностранных ученых), Новосибирск, 04-08 сентября 2023 года. – Москва: Издательство "Перо", 2023. – С. 131</li> <li>5. Бобрецова Ю. К. и др. Экспериментальная методика исследования оптического поглощения в волноводных слоях полупроводниковых лазерных гетероструктур // Квантовая электроника. – 2021. – Т. 51. – №. 2. – С. 124-128.</li> <li>6. Багаев Т. А. и др. Мощные полупроводниковые гибридные импульсные лазерные излучатели в диапазоне длин волн 900- Верно: 920 нм //Квантовая электроника. – 2021. – Т. 51. – № 10. – С. 912- 914.</li> <li>7. Данилов А. И. и др. Полупроводниковые лазеры с улучшенными излучательными характеристиками // Квантовая электроника. – 2022. – Т. 52. – № 12. – С. 1079-1087.</li> <li>8. Гаврина П. С. и др. Влияние длины резонатора на выходную оптическую мощность полупроводниковых лазеров-тиристоров на основе гетероструктур</li> </ol>

AlGaAs/GaAs/InGaAs // Физика и техника полупроводников. – 2024. – Т. 58. – №. 2. – С. 96-105.

9. Gavrina P. S. et al. An experimental investigation of the dynamics of on-state propagation in low-voltage laser thyristors based on AlGaAs/InGaAs/GaAs heterostructures //Technical Physics Letters. - 2019. - Т. 45. - С. 374-378.

10. Ladugin M. A. et al. Continuous-wave laser diodes based on epitaxially integrated InGaAs/AlGaAs/GaAs heterostructures //Quantum Electronics. – 2019. - Т. 49. - №. 10. – С. 905-908.